FUJI ELECTRIC

2DI 50Z-100

2-Pack BJT
1000 V
50 A

パワートランジスタモジュール

POWER TRANSISTOR MODULE

■特長：Features

- ●**高耐圧** High Voltage
- ●**フリーホイリングダイオード内蔵** Including Free Wheeling Diode
- ●**ASO が広い** Excellent Safe Operating Area
- ●**絶縁形** Insulated Type

■用途：Applications

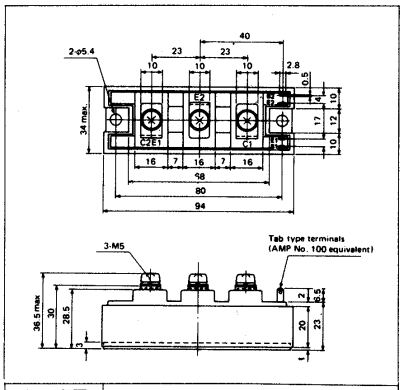
- ●**大電力スイッチング** High Power Switching
- ●**AC モータ制御** A.C Motor Controls
- ●**DC モータ制御** D.C Motor Controls
- ●**無停電電源装置** Uninterruptible Power Supply

■定格と特性：Maximum Ratings and Characteristics

●**絶対最大定格**：Absolute Maximum Ratings

Items		Symbols	Ratings	Units
コレクタ・ベース間電圧		V_{CBO}	1000	V
コレクタ・エミッタ間電圧		V_{CEO}	1000	V
コレクタ・エミッタ間電圧		$V_{CEO(SUS)}$	——	V
エミッタ・ベース間電圧		V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	DC	I_C	50	A
	1ms	I_{CP}	100	A
	DC	$-I_C$	50	A
ベース電流	DC	I_B	3	A
	1ms	I_{BP}	6	A
コレクタ損失	one Transistor	P_C	400	W
	two Transistors	P_C	800	W
接合部温度		Tj	+150	°C
保存温度		Tstg	−40～+125	°C
重量		m	175	g
絶縁耐圧	AC. 1min	Viso	2500	V
締付けトルク		Mounting ※1	35	kg·cm
		Terminals※1	35	kg·cm

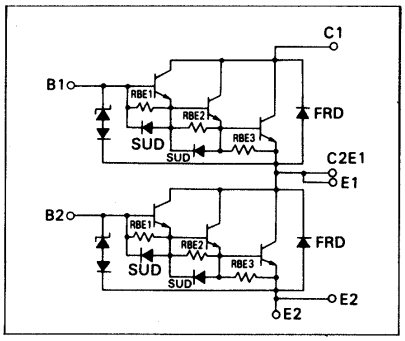
■外形寸法：Outline Drawings



CASE	M204
UL	E82988(M)

■等価回路

Equivalent Circuit Schematic



Note:
※1: 推奨値 Recommendable Value;
M5: 25～30 kg·cm

●**電気的特性**：Electrical Characteristics (Tj=25°C)

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO}	I_{CBO}=1mA	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	I_C=1mA	1000			V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO(SUS)}$					V
	$V_{CEX(SUS)}$	V_{BE}=−3V	1000			V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	I_{EBO}=200mA	10			V
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	V_{CBO}=1000V			1.0	mA
エミッタしゃ断電流	I_{EBO}	V_{EBO}=10V			200	mA
コレクタ・エミッタ間電圧	$-V_{CE}$	$-I_C$=50A			1.8	V
直流電流増幅率	h_{FE}	I_C=50A, V_{CE}=5V	100			——
		I_C=50A, V_{CE}=2.8V, Tj=125°C	75			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(Sat)}$	I_C=50A, I_B=0.7A			2.8	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(Sat)}$				3.5	V
スイッチング時間	t_{on}	I_C=50A			2.5	μs
	t_{stg}	I_{B1}=+0.7A			12.0	μs
	t_f	I_{B2}=−1.0A			2.0	μs
逆回復時間	t_{rr}	$-I_C$=50A, V_{BE}=−6V, $-di/dt$=50A/μs			0.7	μs

●**熱的特性**：Thermal Characteristics

Items	Symbols	Test Conditions	Min	Typ	Max	Units
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Transistor			0.31	°C/W
熱抵抗	$R_{th(j-c)}$	Recovery Diode			1.2	°C/W
熱抵抗	$R_{th(c-f)}$	With Thermal Compound		0.06		°C/W